

## **Практическая работа №2 “Изучение параметров полупроводниковых приборов”**

### **Вариант 1**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов 2С733А, КВ102А, АЛ306Д
2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора 2Д504А
3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора КВ107Г
4. Запишите максимально допустимое обратное напряжение ГД511Б
5. Запишите емкость КВ123А
6. Напишите, для чего применяется варикап
7. Определите марки полученных полупроводниковых диодов.

Выпишите из справочника их электрические параметры и предельные эксплуатационные данные

## **Практическая работа №2 “Изучение параметров полупроводниковых приборов”**

### **Вариант 2**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов 1А304Б, КС405А, 3Л102А
2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора КВ107В
3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора 2Д504А
4. Запишите прямое напряжение КД521В
5. Запишите добротность КВ123А
6. Напишите, для чего применяется туннельный диод
7. Определите марки полученных полупроводниковых диодов.

Выпишите из справочника их электрические параметры и предельные эксплуатационные данные

## **Практическая работа №2 “Изучение параметров полупроводниковых приборов”**

### **Вариант 3**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов ГД107Б, АЛ102А, КУ202Г
2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора КД521В
3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора КВ117А
4. Запишите постоянное обратное напряжение КД504А
5. Запишите рассеиваемую мощность КВ107В
6. Напишите, для чего применяется стабилитрон
7. Определите марки полученных полупроводниковых диодов.

Выпишите из справочника их электрические параметры и предельные эксплуатационные данные

## **Практическая работа №2 “Изучение параметров полупроводниковых приборов”**

### **Вариант 4**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов КД202К, КС211Б, 2В117А
2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора КВ114А-1
3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора КД409А
4. Запишите температурный диапазон функционирования КД521В
5. Запишите постоянное обратное напряжение КВ115А
6. Напишите, для чего применяется выпрямительный диод
7. Определите марки полученных полупроводниковых диодов.

Выпишите из справочника их электрические параметры и предельные эксплуатационные данные

**Практическая работа №2. “Изучение параметров полупроводниковых приборов  
” Вариант 5**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: КТ315Б, 2П145В, 1Т953Г
2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (р-n-p или n-p-n): КТ315, ГТ705
3. Найдите напряжение пробоя транзистора: КТ805А
4. Найдите ток пробоя транзистора: КТ814В
5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: 2Т328Б
6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: ГТ404А

**Практическая работа №2 Изучение параметров полупроводниковых приборов  
Вариант 6**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: 2П280В, КТ487Д, 1Т876Е
2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (р-n-p или n-p-n): КТ361, ГТ701
3. Найдите напряжение пробоя транзистора: КТ803А
4. Найдите ток пробоя транзистора: ГТ403Д
5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: ГТ328А
6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: КП303Г

## **Практическая работа №2 Изучение параметров полупроводниковых приборов**

### **Вариант 7**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: КТ361Г, 1Т979Д, КП579А
2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (р-n-р или n-p-n): КТ608, КТ805
3. Найдите напряжение пробоя транзистора: КТ814Б
4. Найдите ток пробоя транзистора: ГТ404Ж
5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: КТ373Б
6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: ГТ705А

## **Практическая работа №2 Изучение параметров полупроводниковых приборов**

### **Вариант 8**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: 2П479Е, КТ186Е, ГТ765Е
2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (р-n-р или n-p-n): ГТ404, КТ814
3. Найдите напряжение пробоя транзистора: ГТ405Б
4. Найдите ток пробоя транзистора: КТ815Г
5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: ГТ346А
6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: КП307А

## **Практическая работа №2 “Изучение параметров полупроводниковых приборов”**

### **Вариант 9**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов 2С733А, КВ102А, АЛ306Д
2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора 2Д504А
3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора КВ107Г
4. Запишите максимально допустимое обратное напряжение ГД511Б
5. Запишите емкость КВ123А
6. Напишите, для чего применяется варикап
7. Определите марки полученных полупроводниковых диодов.

Выпишите из справочника их электрические параметры и предельные эксплуатационные данные

## **Практическая работа №2 “Изучение параметров полупроводниковых приборов”**

### **Вариант 10**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов 1А304Б, КС405А, 3Л102А
2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора КВ107В
3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора 2Д504А
4. Запишите прямое напряжение КД521В
5. Запишите добротность КВ123А
6. Напишите, для чего применяется туннельный диод
7. Определите марки полученных полупроводниковых диодов.

Выпишите из справочника их электрические параметры и предельные эксплуатационные данные

## **Практическая работа №11 “Изучение параметров полупроводниковых приборов”**

### **Вариант 3**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов ГД107Б, АЛ102А, КУ202Г
2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора КД521В
3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора КВ117А
4. Запишите постоянное обратное напряжение КД504А
5. Запишите рассеиваемую мощность КВ107В
6. Напишите, для чего применяется стабилитрон
7. Определите марки полученных полупроводниковых диодов.

Выпишите из справочника их электрические параметры и предельные эксплуатационные данные

## **Практическая работа №12 “Изучение параметров полупроводниковых приборов”**

### **Вариант 4**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов КД202К, КС211Б, 2В117А
2. Найдите и запишите основные параметры (которые есть в справочнике) полупроводникового прибора КВ114А-1
3. Найдите и запишите предельные эксплуатационные параметры полупроводникового прибора КД409А
4. Запишите температурный диапазон функционирования КД521В
5. Запишите постоянное обратное напряжение КВ115А
6. Напишите, для чего применяется выпрямительный диод
7. Определите марки полученных полупроводниковых диодов.

Выпишите из справочника их электрические параметры и предельные эксплуатационные данные

**Практическая работа №2 “Изучение параметров полупроводниковых приборов  
” Вариант 13**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: КТ315Б, 2П145В, 1Т953Г
2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (р-n-p или n-p-n): КТ315, ГТ705
3. Найдите напряжение пробоя транзистора: КТ805А
4. Найдите ток пробоя транзистора: КТ814В
5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: 2Т328Б
6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: ГТ404А

**Практическая работа №2 Изучение параметров полупроводниковых приборов  
Вариант 14**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: 2П280В, КТ487Д, 1Т876Е
2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (р-n-p или n-p-n): КТ361, ГТ701
3. Найдите напряжение пробоя транзистора: КТ803А
4. Найдите ток пробоя транзистора: ГТ403Д
5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: ГТ328А
6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: КП303Г

## **Практическая работа №2 Изучение параметров полупроводниковых приборов**

### **Вариант 15**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: КТ361Г, 1Т979Д, КП579А
2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (р-n-p или n-p-n): КТ608, КТ805
3. Найдите напряжение пробоя транзистора: КТ814Б
4. Найдите ток пробоя транзистора: ГТ404Ж
5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: КТ373Б
6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: ГТ705А

## **Практическая работа №2 Изучение параметров полупроводниковых приборов**

### **Вариант 16**

1. Расшифруйте названия полупроводниковых приборов: 2П479Е, КТ186Е, ГТ765Е
2. Найдите по справочнику и определите структуру транзистора (р-n-p или n-p-n): ГТ404, КТ814
3. Найдите напряжение пробоя транзистора: ГТ405Б
4. Найдите ток пробоя транзистора: КТ815Г
5. Запишите максимальную мощность, рассеиваемую транзистором: ГТ346А
6. Запишите основные параметры, имеющиеся в справочнике, которыми характеризуются транзисторы, указанные ниже: КП307А